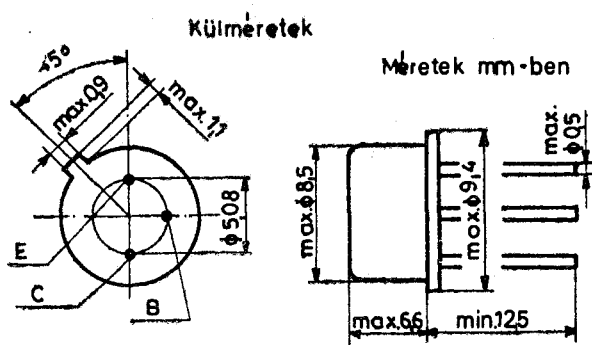


M.E.V. MIKROELEKTRONIKAI VÁLLALAT

IV., Fóti út 56.

1325 Budapest, Pf. 21 Telefon: 691-100 Telex: 22-7306

Nagyfeszültségű szilícium PNP planár tranzisztor 2N 5415 2N 5416



Tok: TO-39
Tömeg: kb 1,5g

A kollektor a fémházzal
össze von kötve.

Ajánlott alkalmazás

A 2N 5415, 2N 5416 nagyfeszültségű szilícium epitaxiális planár PNP tranzisztor közszükségleti és ipari felhasználásra szolgál. Elsősorban meghajtóként alkalmazható nagyfeszültségű kis áramú inverterekben, kapcsoló és soros üzemű stabilizátorokban.

Bármely alkalmazástechnikai kérdésben a MEV Félvezető Ágazat Fejlesztése készséggel áll felhasználóink rendelkezésére (Telefon: 692-800/2337).

Schronk László

MAXIMÁLIS HATÁRADATOK	JELÖLÉS	2N 5415	2N 5416	EGYSÉG
Kollektor-bázis feszültség	$-V_{CB0}$	200	350	V
Kollektor-emitter feszültség	$-V_{CE0}$	200	300	V
Emitter-bázis feszültség	$-V_{EB0}$	4	6	V
Kollektor egyenáram	$-I_C$	1	1	A
Bázis egyenáram	$-I_B$	0,5	0,5	A
TELJES TELJESÍTMÉNYDISSZIPÁCIÓ				
$T_{amb} 50^\circ C$	P_{tot}	1	1	W
$T_{case} 25^\circ C$	P_{tot}	10	10	W
Átmeneti hőmérséklet	T_j	150	150	$^\circ C$
Tárolási hőmérséklet	T_s	- 55...+150		$^\circ C$
HŐELLENÁLLÁS				
átmenet és tok között	R_{thjc}	17,5	17,5	K/W
átmenet és környezet között	R_{thja}	150	150	K/W

STATIKUS JELLEMZŐK $T_{case} = 25^\circ C$ ha másként nincs meghatározva	JELÖLÉS	2N 5415	2N 5416	EGYSÉG
Kollektor-bázis visszáram ($I_E = 0$) $-V_{CB} = 175V$ $-V_{CB} = 280V$	$-I_{CB0}$ $-I_{CB0}$	≤ 50	≤ 50	μA μA
Kollektor-emitter visszáram ($I_B = 0$) $-V_{CE} = 150V$	$-I_{CEO}$	≤ 50	≤ 50	μA
Emitter-bázis visszáram ($I_C = 0$) $-V_{EB} = 4V$ $-V_{EB} = 6V$	$-I_{EBO}$ $-I_{EBO}$	≤ 20	≤ 20	μA μA
Tartás kollektor-emitter feszültség* ($I_B = 0$) $-I_C = 10mA$	$-V_{CEO(sus)}$	≥ 200	≥ 300	V
Tartós kollektor-emitter feszültség* ($R_{BE} = 50\Omega$) $-I_C = 50mA$	$-V_{CER}$		≥ 350	V
Kollektor-emitter maradék feszültség* $-I_C = 50mA$, $I_B = 5mA$	$-V_{CE sat}$	$\leq 2,5$	$\leq 2,5$	V
Bázis-emitter feszültség* $-I_C = 50mA$, $V_{CE} = 10V$	$-V_{BE}$	$\leq 1,5$	$\leq 1,5$	V
Egyenáramú áramerősítési tényező* $-I_C = 20mA$, $V_{CE} = 10V$	h_{21E} h_{21E}	≥ 30 ≤ 150	≥ 30 ≤ 120	

* Impulzus üzem: impulzus hossza = $300\mu s$ kitöltési tényező $\leq 2\%$.

DINAMIKUS JELLEMZŐK $T_{case} = 25^\circ C$	JELÖLÉS	2N 5415	2N 5416	EGYSÉG
Kisjelű áramerősítési tényező $-I_C = 5mA$, $-V_{CE} = 10V$, $f = 1kHz$	h_{21e}	> 25	> 25	
Kollektor-bázis kapacitás $-V_{CB} = 10V$, $f = 1MHz$	C_{B0}	< 25	< 25	pF
Tranzitfrekvencia $-I_C = 10mA$, $-V_{CE} = 10V$, $f = 5MHz$	f_T	> 15	> 15	MHz



M.E.V. MIKROELEKTRONIKAI VÁLLALAT